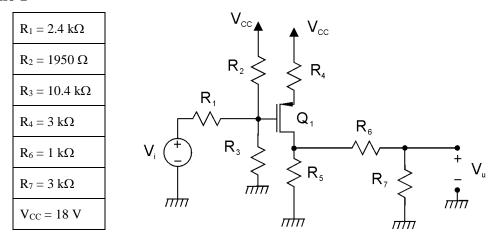
ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 26 gennaio 2021

Esercizio 1



 Q_1 è un transistore MOS a canale p resistivo con V_T = -1 V e la corrente di drain in saturazione data da $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$ con k = 0.5 mA/V².

Con riferimento al circuito in figura:

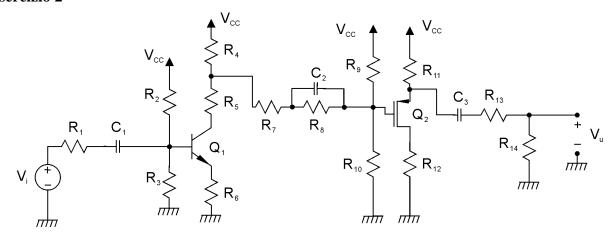
- 1) calcolare il valore della resistenza R_5 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione di uscita V_u sia 4.5~V:
- 2) determinare il punto di riposo del transistore Q₁ e verificarne la saturazione;
- 3) determinare l'espressione dei parametri per il modello di piccolo segnale del transistore Q₁ e disegnare il circuito equivalente per piccoli segnali.

ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 26 gennaio 2021

Esercizio 2



 Q_1 è un transistore BJT BC109B resistivo con $h_{re} = h_{oe} = 0$; Q_2 è un transistore MOS a canale p resistivo con la corrente di drain in saturazione data da $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$ e $g_m > 0$.

Con riferimento al circuito in figura:

1) determinare l'espressione di V_U/V_i alle frequenze per le quali i condensatori possono essere considerati dei corto circuiti.

ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 26 gennaio 2021

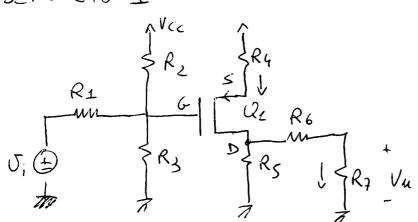
Esercizio 3

Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = A\bar{B} + \bar{C}(\bar{D} + \bar{A})E$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento di tutti i transistori.

APPELLO 26/01/2021



$$R_{1} = 2.4 K \Omega$$
 $R_{2} = 1350 \Omega$

$$I_7 = \frac{Vu}{R_7} = 1.5 \text{ mA}$$

hp:
$$Q_1$$
 sotur =) $I_0 = K (V_{05} - V_7)^2$

$$T_{D} = K \left(V_{O} - V_{S} - V_{T} \right)^{2} \times \left(V_{O} - V_{CC} + R_{G} + D_{O} - V_{T} \right)^{2}$$

$$V_{S} = \left(V_{CC} - R_{G} + D_{O} \right)$$

$$V_{S} = \left(V_{CC} - R_{G} + D_{O} \right)^{2} \times \left(V_{CC} + R_{G} + D_{O} - V_{T} \right)^{2}$$

$$V_{S} = (V_{CC} - K_4 + D)$$

$$T_{D} = K(9 - 18 + 3x10^{3} I_{D} + 1)^{2} = K(-8 + 3x10^{3} I_{D})^{2} = \frac{1}{3} = \frac$$

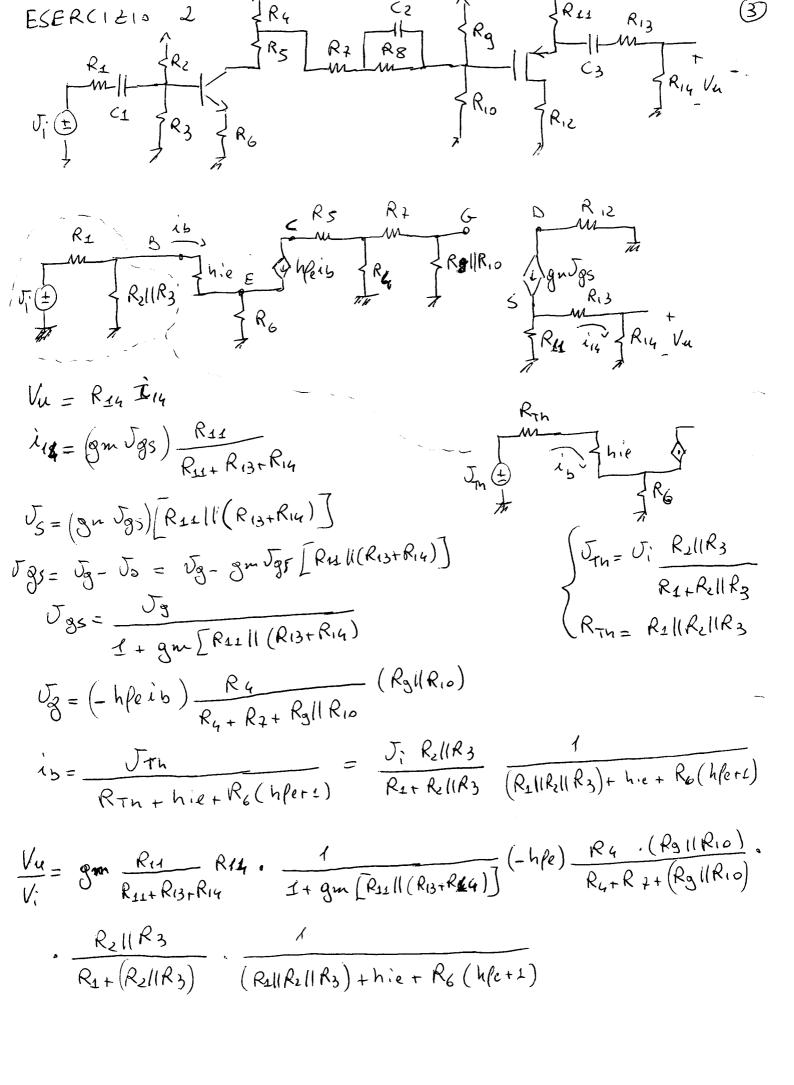
$$= K \left(64 + 3 \times 10^6 I_0^2 - 48 \times 10^3 I_0 \right) =$$

$$4.5 \times 10^3 \text{ To}^2 - 25 \text{ Fo} + 32 \times 10^{-3} = \phi$$

$$4.5 \times 10^{3} = \frac{10^{2} - 25 + 32 \times 10^{3}}{10^{2} + 32 \times 10^{3}} = \frac{25 \pm 7}{8 \times 10^{3}} = \frac{25 \pm 7}{10^{2}} = \frac{25 \pm 7}{10$$

Se THENERS ID = FOI = 3.5 mA =)
$$V_S = 7.3$$
 V => $V_{GS} = 1.6$ V > $V_T = 41$ V =) $\frac{100}{100}$

Per ai z ha $I_0 = 2mA$ Is= ID-I7= 0,5 m 4 $R_{S} = \frac{V_{0}}{I_{c}} = \frac{12 \, \text{KD}}{I_{c}}$ VDS = VD-VS = 6-12 = -6V < (VOS-VT) = -3+1 = -2V => hp OK "Supaturdant gn = 2K | Vos-41 = 2×10-3 4 I pt di ripro di le ? $Q_1: \begin{cases} T_0 = 2mA \\ V_{DS} = -6V \end{cases}$ $V_{6S} = -3V$ $Q_m = 2 \times 10^{-3} \text{ A/V}$ Il wrut equirante per picchi seguli è



$$Y = A - \overline{D} + \overline{C} \cdot (\overline{D} + \overline{A}) \cdot E \qquad N = 2 \times 6 + 2 \times 2 = 16$$

$$A - \frac{1}{12} \cdot \overline{A} \qquad E - \frac{1}{12} \cdot \overline{A}$$

CONTRONTO LIALEA DEI DUE CASI USANDO LE SOMME DEI W

CASE 1 $\frac{3}{1}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{3}{1}$	OMTA
CASO 1 $\frac{3}{2}$ M $\frac{3}{2}$ M $\frac{6}{2}$ M	_
case 2 2m 2m 2m 6m	•

Te dre obsidni SONO ECVINALENTI IN ARTA